

规格表

第8代G8H IGBT系列产品规格表

650V产品

项目	规格	
产品编号	RBN40H65T1GPQ-A0 (40A) RBN50H65T1GPQ-A0 (50A) RBN75H65T1GPQ-A0 (75A)	
型号名称	RBN40H65T1GPQ-A0#T2 RBN50H65T1GPQ-A0#T2 RBN75H65T1GPQ-A0#T2	
集电极到发射极电压 VCES	650 V	
栅极到发射极电压 VGES	+/- 30 V	
集电极电流 IC	Tc = 25 °C	80 A, 100A, 150A
	Tc = 100 °C	40 A, 50A, 75A
结温 Tj	175 °C	
集电极到发射极饱和电压 VCE (饱和)	1.5 V	
栅极到发射极截止电压 VGE (关闭)	5.0 - 6.8 V	
封装信息	TO-247	

1250 V产品

项目	规格	
产品编号	RBN25H125S1GPQ-A0 (25A) RBN40H125S1GPQ-A0 (40A) RBN75H125S1GP4-A0 (75A)	
型号名称	RBN25H125S1GPQ-A0#T2 RBN40H125S1GPQ-A0#T2 RBN75H125S1GP4-A0#T2	
集电极到发射极电压 VCES	1250 V	
栅极到发射极电压 VGES	+/- 30 V	
集电极电流 IC	Tc = 25 °C	50 A, 80A, 150A
	Tc = 100 °C	25 A, 40A 75A
结温 Tj	175 °C	
集电极到发射极饱和电压 VCE (饱和)	2.1 V	
栅极到发射极截止电压 VGE (关闭)	5.0 - 6.8 V	
封装信息	TO-247	TO-247 plus

(备注) 所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。